



پژوهشکده لیزر و پلاسما

اولین کنفرانس ملی حسگرهای فیبر نوری - ۶ آبان ۱۴۰۰

ICOFS 2021

1st Iranian Conference on Optical Fiber Sensors

October 28, 2021



اندازه‌گیری نوری ضخامت لایه‌های نیمه هادی

پدرام رضایی سیروس، سعید باطبی

گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده: با توسعه فناوری نانو، نیاز به ساخت و توسعه ابزارهای اندازه‌گیری جز لاینفک تحقیقات بشمار می‌رود. در این پژوهش به طراحی و ساخت سیستم اندازه‌گیری نوری غیرتماسی ضخامت لایه‌های نیمه هادی پرداخته شده است. با استفاده از یک لیزر قرمز با طول موج ۶۳۲٫۸ نانومتری (توان ۲ میلی وات)، طراحی اپتیکی مناسب و چیدمان تداخل سنج فابری پرو فریزهای تداخلی بدست می‌آیند. فریزهای کروی بدست آمده با تغییر ضخامت سطحی بصورت مداوم تغییر می‌نمایند، و با شمارش این خطوط ضخامت لایه بدست می‌آید. با چیدمان مناسب اپتیکی، تشکیل این خطوط، طراحی مدار الکترونیکی و استفاده از هوش مصنوعی ضخامت لایه نیمه هادی را با چندین روش مختلف اندازه گرفته شده است. در این بین به بررسی هر روش پرداخته و در آخر با استفاده از فتودیود Tsl 250 و استفاده از تحلیل ویدیو بهترین نتیجه و حداقل اندازه گیری ۶۰۰ نانومتر ثبت شد.

کلید واژگان: میکروسکوپ نوری؛ تداخل سنج فابری پرو؛ اندازه‌گیری ضخامت نیمه‌هادی

Optical measurement of semiconductor layer

Pedram Rezaee Sirous, Saeed Batebi

Dept. of Physics, Faculty of Basic Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran

Abstract- One of the requirements of research in the field of Nanotechnology is making and developing equipment for observing and measuring. In this study, a non-contact optical system is designed and made for measurement of semiconductor layer thickness. A red laser with a 632.8 nm wavelength (power of 2 mW), a proper optical design and arrangement of Fabry Perot interferometer are used for interference fringes. As the thickness of semiconductor layer varies, the fringe spherical interference constantly changes as well. Then, the thickness of layers can be gauged by counting the lines. The variations are measured through several methods by a suitable optical set up, forming spherical lines, designing integrated circuit and using artificial intelligence. Meanwhile, the measurement methods were investigated. Finally, the best result and minimum measurement of 600 nm was recorded using image and video analysis by MATLAB program and utilizing photodiode Tsl 250.

Keywords: : Optical microscope; Fabry Perot interferometer; measurement of semiconductor layer

۱- مقدمه

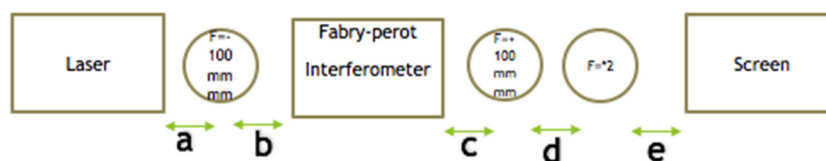
با توسعه فناوری‌های جدید اعم از نانو، فیبر نوری، فتونیک و ...، نیاز به ساخت و توسعه ابزارهای مشاهده و اندازه‌گیری جز جدا نشدنی تحقیقات بشمار می‌رود. در این رابطه انواع میکروسکوپ‌ها اعم از میکروسکوپ نیروی اتمی گرفته تا میکروسکوپ نوری نقش محوری در این نوع تحقیقات را بر عهده دارند. اندازه‌گیری ضخامت با دقت نانومتری برای کاربردهای متنوعی نظیر لایه‌نشانی فیلم‌های اپتیکی، قطعات نیمه هادی، لایه‌های نازک، ابزارآلات فتونیک و سلول‌های خورشیدی اهمیت بسزایی دارد. بدست آوردن ضخامت و تکستایل سطح توسط دستگاه‌های متنوعی انجام می‌شود، اما به منظور تسهیل کار در روند پژوهش، استفاده از دستگاه‌های آنالیز و ساده بیشتر مورد استقبال قرار می‌گیرد [۱]. برای این هدف میکروسکوپ‌های نوری با ستاپ‌های مختلف وجود دارند. استفاده از تداخل‌سنج فابرو پرو چیدمان مناسبی برای اندازه‌گیری ضخامت است [۲]. در این بین با طراحی و انتخاب‌های مختلف سرعت، قیمت و دقت ابزار اندازه‌گیری متفاوت خواهد بود. بطور مثال هرچه شدت نور هر فریز بیشتر شود و هر خط محوتر می‌شود. اما فاصله ی بین فریز ها کمتر می‌شوند و این موضوع اندازه‌گیری را سخت‌تر و محدودتر می‌کند [۳].

۲- انجام پژوهش

برای اندازه‌گیری ابتدا بایستی فریزهای تداخلی شکل گیرند. با استفاده از یک لیزر قرمز با طول موج ۶۳۲٫۸ نانومتری (توان ۲ میلی‌وات) و طراحی چیدمان اپتیکی و با استفاده از تداخل سنجی فابری پرو خطوط کروی (فریزها) ایجاد شدند.

۲-۱. چیدمان آزمایش

اساس این آزمایش و پژوهش مطابق با اصول تداخل سنج فابری پرو چیده می‌شود. با تغییر فواصل مشخص شده و موقعیت لایه مورد نظر برای اندازه‌گیری نتایج مختلف ثبت شده است.



شکل ۱) چیدمان پژوهش

حال با تغییر ضخامت لایه نیمه هادی خطوط کروی بطور پیوسته تغییر می‌کنند. برای اندازه‌گیری تغییرات این خطوط از دو روش الکتریکی و تصویری استفاده شده است.

۲-۲. نتایج

در روش اول با طراحی یک مدار الکتریکی قابل برنامه نویسی و فتودیود اندازه‌گیری تغییرات انجام شده است. در روش دوم با استفاده از سیستم تحلیل تصویر و ویدیو در برنامه متلب اقدام به شمارش خطوط تداخلی شد. در روش اول فریزها بر روی پرده‌ای که فتودیودها بر روی آن نصب هستند، تشکیل می‌شود. از یک نمایشگر هم برای تبدیل و خواندن کاربر از تغییرات فریزها استفاده شده است. در این بین از دو مدل مختلف فتودیود Tsl1401 و Tsl 250 استفاده شد. که سنسور Tsl 250 نتایج بهتری را رقم زد. و در روش دوم فریزها بر روی پرده

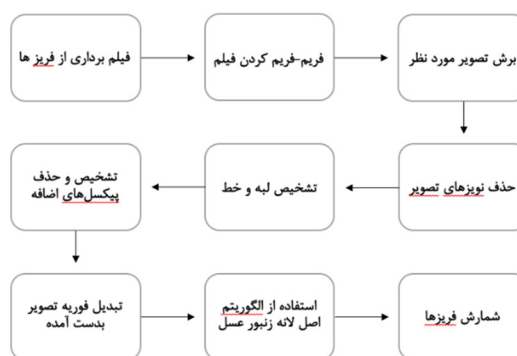
۳-۲. نتیجه گیری

Original Image

Motion Blurred Image

Blurred Image

Sharpened Image



شکل ۳) فلوجارت کلی پردازش ویدیو انجام شده برای فریزها

ΣΑ

این مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت <http://opsi.ir/> قابل دسترسی باشد.